

Содержание

К 100-летию юбилею Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН	3
--	----------

Георгиевский П.Ю., Левин В.А., Сутырин О.Г.

Пространственные эффекты при взаимодействии ударной волны с продольным каналом газа пониженной плотности	5
--	---

Данченко Н.Г., Дубинов А.Е., Кожаева Ю.П.

Измерение количества вещества, испаряемого с поверхности вязкой диэлектрической жидкости при наносекундном барьерном разряде	14
--	----

Хрусталёв А.П., Гаркушин Г.В., Жуков И.А., Разоренов С.В.

Влияние структуры металломатричного композита магний-нитрид алюминия на его сопротивление деформированию при квазистатическом и динамическом нагружении	21
---	----

Дерябин А.С., Соколов Л.В., Труханов Е.М., Фрицлер К.Б.

Достоверность выявления пронизывающих дислокаций в эпитаксиальных пленках с помощью структурно-чувствительного травления	30
--	----

Беляев М.А., Путролайнен В.В., Романенко В.А.

Моделирование деформации многокристалльныхборок NAND-памяти	37
---	----

Долгих Г.И.

Лазерно-интерференционная система детектирования гравитационных волн	46
--	----

Калмыков А.Е., Мясоедов А.В., Сорокин Л.М.

Асимметрия дефектной структуры полуполярного GaN, выращенного на Si(001)	53
--	----

Орешкин В.И.

Рост перегретых неустойчивостей в метастабильном металле	62
--	----

Шурыгина Н.А., Глезер А.М., Дьяконов Д.Л., Томчук А.А., Кадомцев А.Г., Нарыкова М.В.

Влияние температуры деформации в камере Бриджмена на особенности формирования дефектной структуры технически чистого титана 70

Кузнецов В.В., Шамирзаев А.С.

Влияние массовой скорости на величину критического теплового потока при кипении деионизованной воды с недогревом в микроканальной системе охлаждения 79

Черных А.В., Черных С.В., Диденко С.И., Буртебаев Н., Насурлла Маулен, Насурлла Маржан, Бритвич Г.И., Чубенко А.П., Барышников Ф.М., Слепцов Е.В.

Арсенид-галлиевые детекторы с барьером Шоттки для спектрометрии альфа-частиц при температурах до 120°С 87

Черемисин А.Б., Кулдин Н.А.

Коррелированное изменение электрических характеристик тонкопленочного полевого транзистора при модификации физических свойств его оксидного полупроводникового канала (InZnO:N) 95

Громов А.В., Гойхман М.Б., Ковалев Н.Ф., Палицин А.В., Fuks M.I., Schamiloglu E.

Низкоэнергетическое состояние электронного пучка в коаксиальном диоде с однородным анодом и неоднородным профилем магнитного поля 102